Joan CHILLY PAU

パーペ こ

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

2000-076689 (11)Publication number:

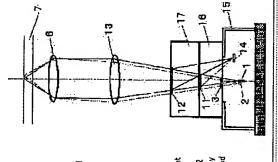
(43)Date of publication of application: 14.03.2000

(72)Inventor: KAMIYAMA TETSUO (71)Applicant: SHARP CORP 6118 7/135 (21)Application number: 10-244262 31.08.1998 (22)Date of filing: (51)Int.Cl.

### (54) OPTICAL PICKUP DEVICE

wavelengths, easy to assemble and adjust, and moreover suitable which is compatible with plural recording and reproducing optical PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical pickup device disks to different standards by using light beams of different for miniaturization and integration.

is separated into three beams through the diffraction grating 3, they are focused on the disk 7, and the reflected return light is diffracted somiconductor lasor 1 is focused on a disk 7, and the reflected light photodetector 14. After the light emitted from the semiconductor 2 SOLUTION: 1st semiconductor laser 1 oscillating in a 650 nm band hologram element 11 diffracting only the 2nd semiconductor laser ight, and a four-splitting 1st hologram element 12 diffracting only arranged proximately. A 3-beam purpose diffraction grating 3 for the laser light of the 1st semiconductor laser are arranged in the by the hologram element 11 and guided to the photodetector 14. and 2nd semiconductor laser 2 oscillating in a 780 nm band are generating three beams for tracking control, a two-splitting 2nd optical axes of the 1st semiconductor laser 1 and the 2nd is diffracted by the hologram element 12 and guided to a somiconductor laser 2. The light emitted from the 1st



ഗ	
≌	
_	
Ξ	
⋖	
ᅩ	
_	

09.04.2002 examiner's decision of rejection or application converted [Dato of sanding the examiner's decision of rejection] Kind of final disposal of application other than the [Date of request for examination]

registration]

[Date of final disposal for application]

08.08.2003 3459777 [Date of registration] [Patent number]

2002-07989 [Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of 08.05.2002 rejection

[Date of extinction of right]



(12)

(16) 日本因各群庁 ( J b )

開特許公報(4)

**梅期2000-76689** (11)特許出限公開兼与

103237/

(43)公開日 平成12年3月14日(2000.3.14) (P2000-76689A)

5D119 7/135 G11B

觀別記中

G11B 7/135

(51) Inta.?

都強能水 未踏水 耐水畑の数9 〇L (全 10 耳)

(21) 出職等与	特 <b>图</b> 平10-24262	(71) 出國人 000005049	000005049	
			シャーン株式会社	
(22) 出版日	平成10年8月31日(1998.8.31)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	
		(72) 発明者	上山 微男	
			大阪府大阪市阿倍野区長池町2245259 ン	
		_	ャープ株式会社内	
		(74) 代理人 100103296	100103296	
			中国十一 小西 南海	
		トターム(数)	Fターム(参考) 5D119 AA04 AA38 AA39 AA41 BAD1	
			BB01 BB04 CA09 CA16 EA02	
			EA03 ECA1 ECA7 FA05 FA08	
			JA02 JA15 JA22 JA43 JB10	
			KAD8 KA12 KA16 KA17 LB07	
			NA05	

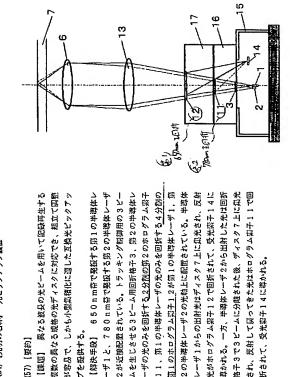
## (54) [発明の名称] 光ピックアップ報酬

【瞬因】 異なる彼及の光ピームを用いて記録再生する **複数の異なる規格の光ディスクに対応でき、組立て顕整** が容易で、しかも小型気積化に適した互換光ピックアッ プを協供する。

11、第1の半苺体レーザの光のみを回折する4分割の 第1のホログラム芸子12が第1の半時体レーザ1,第 苺かれる。一方、半苺体レーザ2から出射した光は回折 一 
ザの光のみを回折する2分割の第2のホログラム 
琛子 2の半導体ワーザ2の光軸上に配置されている。 半導体 レーザ1からの出射光はディスク7上に紅光され、反射 光がホログラム揿干12で回折されて、受光採干14に ムを生じさせる3ピーム用回扩格子3、符2の半導体フ 【解決年段】 650nm符で発位する知1の半時体レ ーヂ1と、180nm符で熟版する街2の半路体ワー步 2が近接配置されている。トラッキング制御用の3ピー

格干3で3ピームに分離された後、ディスク1上に槙光

折されて、受光料子14に導かれる。



BEST AVAILABLE COPY

Searching PAJ Page 1 of 2

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-076689

(43) Date of publication of application: 14.03.2000

(51) Int. Cl.

G11B 7/135

(21) Application number : 10-244262

(71) Applicant: SHARP CORP

(22) Date of filing:

31. 08. 1998

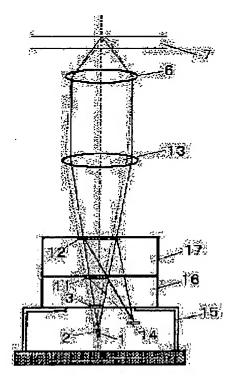
(72) Inventor: KAMIYAMA TETSUO

### (54) OPTICAL PICKUP DEVICE

### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical pickup device which is compatible with plural recording and reproducing optical disks to different standards by using light beams of different wavelengths, easy to assemble and adjust, and moreover suitable for miniaturization and integration.

SOLUTION: 1st semiconductor laser 1 oscillating in a 650 nm band and 2nd semiconductor laser 2 oscillating in a 780 nm band are arranged proximately. A 3-beam purpose diffraction grating 3 for generating three beams for tracking control, a two-splitting 2nd hologram element 11 diffracting only the 2nd semiconductor laser light, and a four-splitting 1st hologram element 12 diffracting only the laser light of the 1st semiconductor laser are arranged in the optical axes of the 1st semiconductor laser 1 and the 2nd semiconductor laser 2. The light emitted from the



1st semiconductor laser 1 is focused on a disk 7, and the reflected light is diffracted by the hologram element 12 and guided to a photodetector 14. After the light emitted from the semiconductor 2 is separated into three beams through the diffraction grating 3, they are focused on the disk 7, and the reflected return light is diffracted by the hologram element 11 and guided to the photodetector 14.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.07.2000

[Date of sending the examiner's decision 09.04.2002

of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of final disposal for application]			
[Patent number]	3459777		
[Date of registration]	08. 08. 2003		
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]	2002-07989		
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]	08. 05. 2002		

(19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2000-76689

(P2000-76689A)

(43)公開日 平成12年3月14日(2000.3.14)

(51) Int.CL?

織別配号

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 7/135

G11B 7/135 5D119

### 審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 10 頁)

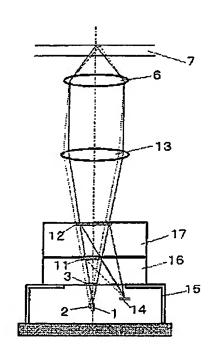
(21)出麻番号	特顧平10-244262	(71) 出庭人 000005049
(22)出版日	平成10年8月31日(1998.8.31)	シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22巻22号 (72)発明者 上山 微男 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 (74)代理人 100103296 弁理士 小池 陸編 Fターム(参考) 5D119 AAG4 AA38 AA39 AA41 BAG1 BBG1 BBG4 CAG9 CA16 EAG2 EAG3 ECA1 ECA7 FAG5 FAG8 JAG2 JA15 JA22 JA43 JB10 KAG8 KA12 KA16 KA17 LBO7 NAG5

### (54) 【発明の名称】 光ピックアップ装置

### (57)【要約】

【課題】 異なる波長の光ビームを用いて記録再生する 複数の異なる規格の光ディスクに対応でき、組立て調整 が容易で、しかも小型集積化に適した互換光ピックアッ ブを提供する。

【解決手段】 650 n m帯で発振する第1の半導体レ ーザ1と、780mm帯で発振する第2の半導体レーザ 2が近接配置されている。トラッキング制御用の3ビー ムを生じさせる3ビーム用回折格子3. 第2の半導体レ ーザの光のみを回折する2分割の第2のホログラム素子 11. 第1の半導体レーザの光のみを回折する4分割の 第1のホログラム素子12が第1の半導体レーザ1,第 2の半導体レーザ2の光軸上に配置されている。半導体 レーザ!からの出射光はディスク7上に集光され、反射 光がホログラム素子12で回折されて、受光素子14に 導かれる。一方、半導体レーザ2から出射した光は回折 格子3で3ビームに分離された後、ディスク7上に集光 され、反射して戻ってきた光はホログラム素子11で回 折されて、受光素子14に導かれる。



(2)

特開2000-76689

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の波長の光ビームを出射する第1の 光源と、

第1の波長とは異なる第2の波長の光ビームを出射する 第2の光源と、

第1の波長の光ビームを回折して受光素子へと導くとと もに、第2の波長の光ビームを略回折しない第1のホロ グラム案子と.

第2の波長の光ビームを回折して前記受光素子へと導く とともに、第1の波長の光ビームを略回折しない第2の 19 成されていることを特徴とする光ビックアップ。 ホログラム素子と、を値えていることを特徴とする光ビ ックアップ装置。

【請求項2】 第1の波長の光ビームを発生する第1の 光源と、

第1の波長とは異なる第2の波長の光ビームを発生する 第2の光源と、

第1の光源、第2の光源の少なくとも一方の出射光の光 ディスクへの光路中に配され、第1の波長と第2の波長 の少なくとも一方の波長の光を3ビームに分割するビー ム分割用回折格子と、

第1の光源、第2の光源からの出射光の前記光ディスク への光路中に配され、前記光ディスクから反射された第 1の波長の光を回折して受光素子へ導くと共に、第2の 波長の光を回折しない第1のホログラム素子と.

第1の光源, 第2の光源からの出射光の前記光ディスク への光路中に配され、前記光ディスクから反射され、第 1のホログラム素子を透過した第2の液長の光を回折し て前記受光素子へ導くと共に、第1の波長の光を回折し ない第2のホログラム素干と、を値えたことを特徴とす る光ビックアップ装置。

【詰求項3】 請求項1または請求項2に記載の光ピッ クアップ装置において、

第1および第2のホログラム素子は、それぞれ第1およ び第2の波長の光に対しては0次回折効率と1次または - 1次回折効率の積が最大になるように形成されている ことを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載 の光ピックアップ装置において、

第1のホログラム素子, 第2のホログラム素子は、それ ぞれ第1の基板、第2の基板に、独立して調整可能に形 40 する。 成されていることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項5】 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載 の光ビックアップ芸聞において、

第1及び第2のホログラム素子は、略同一光輪上に補屋 された第1の基板、第2の基板にそれぞれ形成されてお O.

第1の基板と第2の基板の互いに接触する面に形成され たホログラム素子は、ホログラムの形成部分がその周辺 の墓板面よりも低く形成されていることを特徴とする光 ピックアップ装置。

【語求項6】 語求項1乃至請求項3のいずれかに記載 の光ピックアップ装置において、

第1及び第2のホログラム素子は、略同一光軸上に補煙 された第1の基板、第2の基板にそれぞれ形成されてお

第1のホログラム素子、第2のホログラム素子の一方は 第1の基板と第2の基板の互いに接触する面に形成され ており、他方のホログラム素子が形成された基板におけ る前記一方のホログラム素子に対向する部位に凹部が形

【請求項7】 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載 の光ビックアップ装置において、

第1及び第2のホログラム素子は、略同一光輪上に配置 された第1の墓板、第2の墓板にそれぞれ形成されてお

第1の基板と第2の基板は、スペーサを介して積層され ていることを特徴とする光ピックアップ。

【語求項8】 語求項2に記載の光ピックアップ装置に おいて、

26 第1及び第2のホログラム素子は、略同一光軸上に配置 された第1の墓板、第2の墓板にそれぞれ形成されてお

第2の基板における第2のホログラム素子の形成面の反 対側の面に、前記ビーム分割用回折格子が形成されてい ることを特徴とする光ピックアップ装置。

【請求項9】 請求項1乃至請求項8のいずれかに記載 の光ビックアップ装置において、

第1の光源は650mm帯の赤色レーザで、第2の光源 は780 nm帯の赤外レーザであり、第1のホログラム 30 素子の漢深さが1.7~1.8 µmで、第2のホログラ ム素子の漢深さが1.3~1.4μmに設定されている ことを特徴とする光ピックアップ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスクや光力 ード等の情報記録媒体に対して、光学的に情報を記録再 生する光ピックアップに関するものである。特に、異な る波長の光ビームを用いて記録再生する複数の異なる規 格の光ディスクに対応できる互換光ビックアップを提供

[0002]

【従来の技術】近年、光ディスクは多量の情報信号を高 密度で記録することができるため、オーディオ、ビデ オーコンピュータ等の多くの分野において利用が進めら

【0003】特に、光ディスクにおいては、CD、CD -RやDVDなど種々の異なる規格のディスクが市販さ れており、このような具なる規格のディスクを単一の光 ピックアップで記録または再生できる互換性が要求され 50 ている。CDやCD-Rは被長780nmの赤外光ビー

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/...

(3)

ムに対して基板や記録媒体の特性が最適化されており、 またDVDは波長650nm付近の赤色光ビームに対し て最適化されている。また特定的に400ヵ面前後の青 色光ビームを用いた記録または再生ディスクの開発も進 められている。

【0004】とのような異なる波長で記録または再生さ れるディスクに対して、互換性のある光ピックアップと しては、例えば特闘平9-128794号公報に記載の 光ビックアップが提案されている。

【0005】図12は、特開平9-128794号公銀 16 に記載の光ピックアップの構成を示す図である。この光 ピックアップは、635nm帯で発振する第1の半導体 レーザ1、780nm帯で発振する第2の半導体レーザ 2. 各光源の光ビームからトラッキング制御用の3ビー ムを生じさせる3ビーム用回折格子3.光ビームの偏波 方向によって凹レンズ作用を奏する格子レンズ5. 対物 レンズ6、ディスク7からの反射光を回折させて受光素 子に導くホログラム素子8、および受光素子9とを備え ている。また第1の半導体レーザ1と、第2の半導体レ ーザ2は、互いに偏光方向が直交するように配置されて 20 いる。

【0006】まず、635nm帯の第1の半導体レーザ 1で、基板厚さり、6mmの光ディスクを再生する場合 の動作について説明する。半導体レーザ」から出射した 光は、回折格子3により3ピームに分離され、ホログラ ム素子8を透過した後、格子レンズ5では作用を受けず に対物レンズ6でディスク?の記録面?aに集光され る。反射して戻ってきた光はホログラム素子8で回折さ れて、受光素子9に導かれる。光ビームの偏波方向は格 されている。

【0007】次に、780nm帯の第2の半導体レーザ 2で、基板厚さ1.2mmの光ディスクを再生する場合 の動作について説明する。半導体レーザ2から出射した 光は、同じく回折格子3で3ピームに分離され、ホログ ラム索子8を遠過した後、格子レンズ5では凹レンズ作 用を受けて対物レンズ6でディスク?の記録面?bに集 光される。反射して戻ってきた光も同じくホログラム素 子8で回折されて、受光素子9に導かれる。光ビームの ーンが形成されている。

【0008】なお、格子レンズ5での凹レンズ作用は、 ディスク厚さがり、6mmから1、2mmに厚くなった 場合に発生する球面収差を補正するように設計されてい

【0009】とのような構成においては、例えば第1の 半導体レーザ1に対して、ディスク反射光の回折光が、 受光素子9に導かれるように、ホログラム素子8を設計 している。そして、もう一方の波長の第2の半導体レー 折角の違いによって生じる受光素子9上の位置の違いが キャンセルされるように、半導体レーザ2の配置関係が 設定されている。また第1の半導体レーザからの光も、 第2の半導体レーザからの光も共に回折格子3により3 ビームに分離され、同じ受光素子により、3ビーム法に よるトラッキング誤差信号を検出している。

【0010】とのような配置により、本来2つの受光素 子が必要であったのに対し、1つの受光素子を共通に使 用でき、部品点数や組立工数を削減することができる。 [0011]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の光ビックア ップでは、波長の異なる複数の半導体レーザからの光を 用いて複数種類の光ディスクに対して記録再生する際 に、どちらの波長の光をも共通の受光素子に導くよう に、光源(半導体レーザ)の位置関係を予め求めた所定 の位置関係に配置する必要がある。

【0012】しかしながら、半導体レーザと受光素子を 1つのパッケージに集補化する場合などは、通常、半導 体レーザや受光素子はバッケージ内のステムに位置決め 固定されており、ホログラム素子の調整時には受光素子 側は位置や回転調整ができない場合が多い。つまり、半 導体レーザや受光素子の取付け誤差やホログラム素子取 付け面の形状公差により発生する例えばフォーカス誤差 信号やトラッキング誤差信号のオフセット調整を、ホロ グラム素子の調整だけでを行う場合が多い。このような 場合には、一方の半導体レーザ光源に合うようにホログ ラム素子を調整すると、別の半導体レーザ光源で使用す る場合には最適状態からずれる可能性が高い。すなわ ち、組立て時のホログラム素子の位置調整だけではサー 子レンズ5で作用を受けないような格子パターンが形成 30 ボ誤差信号の最適調整ができないか。または半導体レー ザ、受光素子の取付け公差、バッケージの加工公差など を非常に厳しくする必要がありコストが高くなる。

> 【0013】また、ホログラム素子は受光素子上で希望 の集光特性を得るために、収差結正機能も含んでいる場 合が多いが、異なる複数の液長に対して最適な収差論正 を行うようなホログラムバターン設計も困難である。

【0014】さらに、上記従来の光ビックアップでは、 複数の波長の半導体レーザの光に対して、いずれも3ビ ーム法によるトラッキング誤差信号しか検出できず、異 偏波方向は格子レンズ5で作用を受けるような格子バタ 40 なるトラッキング誤差信号を用いる複数の異なる規格の 光ディスクには適用できない。

> 【0015】本発明は、異なる波長の光ビームを用いて 記録再生する複数の異なる規格の光ディスクに対応で き、組立て調整が容易で、しかも小型集積化に適した互 換光ビックアップを提供することを目的とするものであ る。

[0016]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の光ピッ クアップ装置は、第1の波長の光ビームを出射する第1 ザ2に対しては、ディスク反射光が波長の違いによる回 50 の光源と、第1の波長とは異なる第2の波長の光ビーム

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/...

7/13/2006

(4)

を出射する第2の光源と、第1の波長の光ビームを回折 して受光素子へと導くとともに、第2の波長の光ビーム を略回折しない第1のホログラム素子と、第2の液長の 光ビームを回折して前記受光素子へと導くとともに、第 1の波長の光ビームを略回折しない第2のホログラム素 子と、を償えているものである。

5

【0017】請求項2に記載の光ピックアップ装置は、 第1の波長の光ビームを発生する第1の光源と、第1の 波長とは異なる第2の波長の光ビームを発生する第2の の出射光の光ディスクへの光路中に配され、第1の波長 と第2の波長の少なくとも一方の波長の光を3ビームに 分割するビーム分割用回折格子と、第1の光源、第2の 光源からの出射光の前記光ディスクへの光路中に配さ れ、前記光ディスクから反射された第1の波長の光を回 折して受光素子へ導くと共に、第2の波長の光を回折し ない第1のホログラム素子と、第1の光源,第2の光源 からの出射光の前記光ディスクへの光路中に配され、前 記光ディスクから反射され、第1のホログラム索子を逐 過した第2の波長の光を回折して前記受光素子へ導くと 26 mに設定されているものである。 共に、第1の波長の光を回折しない第2のホログラム素 子と、を償えたものである。

【0018】請求項3に記載の光ピックアップ装置は、 請求項1または請求項2に記載の光ビックアップ装置に おいて、第1および第2のホログラム素子は、それぞれ 第1および第2の波長の光に対しては()次回折効率と1 次または一1次回折効率の積が最大になるように形成さ れているものである。

【()()19】請求項4に記載の光ピックアップ装置は、 ブ装置において、第1のホログラム素子、第2のホログ ラム素子は、それぞれ第1の基板、第2の基板に、独立 して調整可能に形成されているものである。

【0020】請求項5に記載の光ピックアップ装置は、 請求項1万至請求項3のいずれかに記載の光ピックアッ ブ装置において、第1及び第2のホログラム素子は、略 同一光軸上に積層された第1の基板、第2の基板にそれ ぞれ形成されており、第1の基板と第2の基板の互いに 接触する面に形成されたホログラム素子は、ホログラム の形成部分がその周辺の基板面よりも低く形成されてい 40 3 第1の半導体レーザの光のみを回折する第1のホロ るものである。

【0021】請求項6に記載の光ピックアップ装置は、 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の光ピックアッ ブ装置において、第1及び第2のホログラム素子は、略 同一光輪上に積層された第1の基板、第2の基板にそれ ぞれ形成されており、第1のホログラム素子、第2のホ ログラム素子の一方は第1の基板と第2の基板の互いに 接触する面に形成されており、他方のホログラム素子が 形成された基仮における前記一方のホログラム素子に対 向する部位に凹部が形成されているものである。

【0022】 詰求項7に記載の光ピックアップ装置は、 請求項1万至請求項3のいずれかに記載の光ピックアッ ブ装置において、第1及び第2のホログラム素子は、略 同一光輪上に配置された第1の基板、第2の基板にそれ ぞれ形成されており、第1の基板と第2の基板は、スペ ーサを介して積層されているものである。

【0023】請求項8に記載の光ピックアップ装置は、 請求項2に記載の光ピックアップ装置において、第1及 び第2のホログラム素子は、略同一光軸上に配置された 光源と、第1の光源、第2の光源の少なくとも一方から 10 第1の基板、第2の基板にそれぞれ形成されており、第 2の基板における第2のホログラム素子の形成面の反対 側の面に、前記ピーム分割用回折格子が形成されている ものである。

> 【10024】請求項9に記載の光ピックアップ装置は、 請求項1万至請求項8のいずれかに記載の光ピックアッ ブ装置において、第1の光源は650nm帯の赤色レー ザで、第2の光源は780nm帯の赤外レーザであり、 第1のホログラム素子の潜深さが1.7~1.8μm で、第2のホログラム素子の漂深さが1.3~1.4 μ

[0025]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図を用いて 詳細に示す。なお、従来例で示した構成要素と同じもの は同一符号で示す。

【0026】なお、以下の実施の形態では、650nm 帯と780 nm帯の光ビームを出射する2つの光源(半 導体レーザ)を有し、780mm帯の光のみを3ビーム に分割して光ディスクに照射する光ビックアップ鉄置に ついて説明する。但し、本発明は、これに限るものでは 請求項1乃至語求項3のいずれかに記載の光ピックアッ 30 なく、照射波長、光ビームの本数等は適宜変更すること が可能である。

> 【0027】 <実施の形態 1 > 図 1 は、本発明の実施の 形態1の光ピックアップ装置の模成を示す模式図であ る。とのピックアップは、基本的には図12と同様の標 成であり、図12と同じ構成要素には同一符号を付す。 【0028】この光ピックアップは、650nm帯で発 続する第1の半導体レーザ1と、780nm帯で発続す る第2の半導体レーザ2が近接配置されて、トラッキン グ制御用の3ヒームを生じさせる3ヒーム用回折格子 グラム素子12.第2の半導体レーザの光のみを回折す る第2のホログラム素子11、コリメータレンズ13、 対物レンズ6および受光素子14を備えている。

【0029】3ビーム用回折格子3、第1のホログラム 素子12, 第2のホログラム素子11は次のように配置 されている。すなわち、透明基板16の下側に回折格子 3が形成され、上側にホログラム素干11が形成されて いる。また、別の透明基板17の上側にホログラム案子 12が形成されている。そして、レーザパッケージ15 50 のレーザ出射面に透明基板16が調整固定され、その上 に透明基板17が調整固定されている。なお、ここで は、1つの基板の両面に一方のホログラム素子と回折格 子を形成し、もろ一方の基板の片面に他方のホログラム 素子を形成する構成としているが、このようにすれば、 部品点数を削減できる。

7

【0030】図2(a)は、650nm帯の第1の半導 体レーザーで、光ディスクを再生する場合の動作を示す 図である。半導体レーザ1から出射した光は回新格子 3. ホログラム素子11および12を透過し、コリメー ィスク7上に集光され、反射して戻ってきた光はホログ ラム素子12で回折されて、受光素子14上に導かれ

【0031】図2(b)は、780nm帯の第2の半導 体レーザ2で、光ディスクを再生する場合の動作を示す 図である。半導体レーザ2から出射した光は回折格子3 で3ピームに分離され、ホログラム素子11、12を透 過し、コリメータレンズ13で平行光にされた後、対物 レンズ6でディスク7上に集光され、反射して戻ってき た光はホログラム素子11で回折されて、受光素子14 20 は、メインビーム(0次透過率)72%、サブビーム に導かれる。

【0032】なお、ホログラム素子11、12は、それ ぞれ半導体レーザ2及び1からの光ビームに対して戻り 光が完光素子14上で希望の集光特性が得られるように 設計されている。

【10033】次に、本実施の形態のホログラム素子1 1. 12について説明する。

### ②ホログラム索子の波長選択性

矩形状のホログラム素子の回折効率を、図3および図4 ムの回折効率は、滞深され、波長入、透明基板の屈折率 nとすると、

①次回折効率(透過率) n。= (cos△φ)\* ±1次回折効率  $\eta_i = (2/\pi \times \sin \Delta \Phi)^i$ 《但し、△Φ=πt (n-1) / λ) で表される。

【0034】図3は、波長650nm及び780nmで の①次及び±1次回折効率と滞深さとの関係を示してい る。また、図4は、0次回折効率と±1次回折効率の行 (往復利用効率)と漂深さの関係を示している。なお、 ここで、ホログラムガラスは石英m=1.457(入=  $650 \, \text{nm}$ ),  $n = 1.454 \, (\lambda = 780 \, \text{nm}) \, EU$ 

【1)035】本実施の形態においては、光の利用効率を かせげるよう。各波長の光ビームに対して、どちらか一 方のホログラム素子ができるだけ多く光を回折して受光 索子に導き、もろ一方のホログラム素子が殆ど光を回折 しない (すなわち、迷光をできるだけ少なくする) よう に、清深さを設定する必要がある。

【0036】したがって、例えば、波長650nmの第 50 FES= (Sa+Sc) - (Sb+Sd)

1の半導体レーザ1の光のみを回折するホログラム素子 12の漢深さを、図4において650nmの回折効率が ほぼりとなり780mmで回折効率が大きくなる約1. 7μmとし、波長780mmの第2の半導体レーザ2の 光のみを回折するホログラム素子11の滞深さを、図4 において780mmの回折効率がほぼりとなり650m mで回折効率が大きくなる約1. 4μmにすれば良い。 【0037】とのとき、ホログラム素子12による波長 650nmの第1の半導体レーザ1の光ビームの往復利 タレンズ13で平行光にされた後、対物レンズ6で光デ 10 用効率は約9%。ホログラム素子11による波長780 nmの第2の半導体レーザ2の光ビームの往復利用効率 は約8%、各ホログラム素子11、12における他方の 波長での回折効率はほぼ()であり、光量の損失や迷光の 発生は生じなくなる。加工公差等も考慮にいれても、ホ ログラム素子12の操深さを1.7~1.8 µm. ホロ グラム素子11の溝深さを1.3~1.4μmに設定す れば、実用レベルの特性が得られる。

> 【()()38]また、3ビーム用の回折格子3は潸深さ 1. 4μmにすることで、波長780nmの光に対して (±1次回折効率)12%で、適当な3ビーム光量比が 得られる。またこのとき650nmの光に対しては回折 効率はほぼ0でほとんど影響を受けない。

> 【0039】②ホログラム素子11.12の分割パター ンおよびサーボ信号検出法

> 図5は、第1の半導体レーザ1の光のみを回折するホロ グラム素子12の分割パターンと、受光素子14の分割 バターンを示している。

【① ①4 ①】ホログラム素子12は、戻り光ビームの実 に示す。グループ幅とランド幅が等しい矩形状ホログラ 36 質的な中心を原点として十字状に4分割された128、 12b、12c. 12dの4つの分割領域を備えてい る。また、受光素子14は、2つの2分割受光領域(1 4a. 14b) と (14c. 14d) とその他の領域1 4 e. 14 (の6つの領域を備えている。 【① ① 4 1 】 図5 (a) のように、合意状態の時には、 ホログラム素子12の分割領域12aで回折された戻り 光が、2分割受光領域(14a、14b)のx方向に延 びる分割線 141上にビームP1を形成し、分割領域1

2 dで回折された戻り光が2分割受光領域(14 c、1 46 4d)のx方向に延びる分割線14m上にビームP2を 形成し、分割領域12cおよび12bがそれぞれ受光領 域14 f、14 e上にビームP3、P4を形成する。 [10042] 光ディスク7が、台集状態から対物レンズ

6側に相対的に近づくと、ビームP1およびP2は、図 5 (b) のように、それぞれ受光領域14 a または14 c側に大きくなる。一方、逆に相対的に遠ざかると図5 (c)のように、それぞれ受光領域14bまたは14d 側に大きくなる。フォーカス誤差信号FESは、との性 質を利用して、ナイフエッジ法により、

特闘2000-76689

(5)

の演算により検出できる。

【0043】また、トラッキング誤差信号TESは、凹 凸ピットが形成された再生専用ディスクでは、SaとS bとSIの和信号と、ScとSdとSeの和信号の位相 を比較演算することにより、位相差法により検出するこ とができる。その他に、(Sa+Sb+Se) - (Sc +Sd+Sf)の演算によって、ブッシュブル法による TESを検出することもできる。さらに、ビームの片側 すなわち分割領域12b.12cまたは分割領域12 a. 12 dの片側の光だけを用いて位相差法やブッシュ 10 ブル法でのTESを生成することも可能である。

【0044】なお、情報再生信号はすべての出方信号の 和から得る。

【0045】次に、第2の半導体レーザの光のみを回折 するホログラム素子11の分割パターンと、その信号検 出法について図6を用いて説明する。なお、受光素子1 4は同じである。

【10046】ホログラム素子11は、X方向の分割線に より2分割された11a、11bの2つの分割領域を値 説明したように、3ピーム用の回折格子3があるため、 レーザからディスクに向かう往路ビームは、ほぼY方向 に沿って3つに分離され、戻り光もY方向に角度をもっ て返ってくる。

【0047】図6(a)のように、メインビームの戻り 光については、合焦状態の時にホログラム素子11の分 割領域11aで回折された光が、2分割受光領域(14 a. 14b)のx方向に延びる分割線14!上にビーム P1を形成し、分割領域11bで回折された光が2分割 4m上にピームP2を形成する。また、+1次のサブビ ームの戻り光については、ホログラム素子11の分割領 域llaとllbで回折された光が、ともに受光領域l 4 e上にビームP3、P4を形成し、-1次のサブビー ムの戻り光については、ホログラム素子11の分割領域 11aと11bで回折された光が、ともに受光領域14 **『上にビームP5、P6を形成するように構成してい** 

【0048】光ディスク7が合焦状態から対物レンズ6 側に組対的に近づくと、ビームPlおよびP2は図6 (b)のように、それぞれ受光領域14bまたは14c 側に大きくなる。逆に、相対的に遠ざかると、図5 (c)のように、それぞれ受光領域14aまたは14d 側に大きくなる。

【りり49】よって、フォーカス誤差信号FESは上記 性質を利用して、シングルナイフェッジ法を用いた場

FES=Sa-Sb または FES=Sc-Sd の消算により検出できる。

【0050】また、ダブルナイフエッジ法を用いた場

 $FES = \{Sb + Sc\} - \{Sa + Sd\}$ の演算により検出できる。

【①051】なお、トラッキング誤差信号TESは、S e-Sfの演算により3ビーム法によるTESを検出す ることができる。

16

【0052】②ホログラム素子11.12の調整 ホログラム素子12の調整の中で重要なFESのオフセ ット調整について説明する。図7(a)(b)はホログ ラム素子12とFES検出用の受光素子14a. 14 b. 14c、14dの部分のみ表示している。設計時 は、上記図5(a)のように、台集状態においてホログ ラム素子12の分割領域12aで回折された光が、2分 割受光領域(14a、14b)のx方向に延びる分割線 141上に集光するようにピームP1を形成し、分割領 域12dで回折された光が2分割受光領域(14c、1 4d)のx方向に延びる分割線l4m上に集光するよう にビームP2を形成している。

【10053】しかしながら、実際のホログラム/レーザ えている。また、ホログラム素子!1の下側には図1で 20 一体化パッケージにおいては、レーザチップや受光素子 の取付け誤差やバッケージ、ステムの加工誤差などによ り、ホログラムとレーザチップと受光素子の相対位置が 設計値よりある公差範囲でずれている。よって図?

> (a)のように集光ビームPl、P2が分割線上からず れたり、集光状態からずれてビームが大きくなったりし ている。そのため、FES= (Sa+Sc) - (S)+ Sd)で演算されるFESが、対物レンズの台無状態に おいてもオフセットを発生することになる。

【0054】そとで、図?(b)のように光軸に垂直な 受光領域(14c、14d)の水方向に延びる分割線1 30 平面内においてホログラム素子12を回転させてビーム P1. P2を分割線上に移動させることにより、FES のオフセットが()になるよう調整を行う。

> 【0055】また、ホログラム素子11についても同様 の調整を行う。図8(a)(b)はホログラム素子11 とFES検出用の受光素子14a、14b、14c、1 4 d の部分のみ表示している。 これは、 FESを14 a と14りの出力差によって検出するシングルナイフエッ ジ法を用いた場合の例であるが、ホログラム12と同様 に回転調整によりオフセットをりになるようにする。

46 【0056】本実施の形態においては、650nmと7 80mmの2つのレーザチップを近接配置している。こ れを図示しないステムに固定する場合に各チップの位置 がある公差範囲でずれて取り付けられたり、レーザ発光 点位置や出射角度などにばらつきがあったりするが、そ れぞれ別のホログラム素子(11、12)でFESのオ フセット調整を行うため、 

高半導体レーザ (1.2) に 対して最適な調整を独立に行うことができる。

【0057】@ホログラム素子の形状

上記光学系においては、図9(a)に示すように、ホロ 56 グラム素子11、12及び回折格子3を形成した2枚の 11

透明基板を重ねて搭載し、位置及び回転調整を行う構成 図である。ガラス基板にエッチング等でホログラムを形 成する場合、ホログラム素子!」のランド部分の上面と ホログラムの形成されていない部分11 と、回折格子 3のランド部分上面と形成されていない部分3 は同一 面になっている。透明基板16を取り付けるレーザバッ ケージ15の上面すなわちレーザ光の出射面は、通常図 9 (a) のように回折格子3が位置する部分は接触しな いようになっているため問題無いが、例えば透明墓板1 6の上面に形成されたホログラム素子 1 1 についてはそ 10 コリメータレンズや対物レンズで小さくなるように設計 の微細構造が透明基板17を重ねた場合に傷つく可能性 がある。これに対する対策を行った例を次に示す。

【0058】図9(b)は透明基板16にホログラム素 子11を形成する場合に、ガラス基板の場合はホログラ ム形成部分を最初にエッチング等でほり掘り下げた後に ホログラムを形成するか、ランド部を同一面からさらに 除去して掘り下げるようにしている。また、プラスチュ クやガラス材料を用いた成型加工の場合でも、ホログラ ム素子部分より周辺部分が高くなるように型形状を形成

【0059】また、図9(c)は透明基板17の下側を 掘り下げた例である。これは、ホログラム素子11の復 維な作製方法を変更しなくてもよいため、精度の高い加 工が容易にできる。

【0060】図9(a)は2枚の透明基板16と17の 間にスペーサを挟んで両者を固定したものである。これ により2枚のホログラム素子を形成した透明基板を重ね て固定した場合でも、両者に挟まれた部分に形成された ホログラムが調整時に傷つくことはない。

ックアップ装置では、近接配置された650 nm帯で発 続する第1の半導体レーザ1と、780nm帯で発振す る第2の半導体レーザ2に対して、トラッキング副御用 の3ビームを生じさせる3ビーム用回折格子3. 第2の 半導体レーザの光のみを回折するホログラム素子11、 第1の半導体レーザの光のみを回折するホログラム案子 12. の順に配置しているが、特にこの順序で構成する 必要はなく、ホログラム素子11と12が別基板に形成 されていればよい。ただ第2の半導体レーザ2の光のみ を回折するトラッキング副御用の3ビームを生じさせる 40 3ビーム用回折格子3とホログラム素子!!は1つの透 明基版の両面に位置決めして形成されている方が調整の 必要が無く有利である。

【0062】また、TESに3ビーム法を使用せずに1 ビームで信号を検出する場合、3ビーム用回折格子は必 要ない。

【0063】 <実施の形態2 > 図10は実施の形態2の 模成を示す模式図である。光ピックアップの構成は基本 的には、実施の形態1(図1)と同様であるが、半導体 レーザチップの取付け方法が異なる。この部分につい

て、図10を用いて説明する。同じ構成要素には同一符 号を示す。

【0064】実能の形態1においては、2つの異なる波 長のレーザチップを近接配置して取り付けていた。しか しながら、レーザチップは光輪に垂直な方向の幅が10 ○~300μm程度はあるため、各発光点間の距離もそ れ以上離れることになり、 図1 に示した光学系において は2つの異なる波長のレーザビームで光軸に傾きが生じ てしまう。光軸傾きによって発生する収差は、ある程度 されているが、発光点間距離が大きくなるとピックアッ プの特性として問題になる。

【0065】そこで、本実能の形態においては、異なる レーザチップからの光ビームの光軸を一致させるため に、プリズムを用いる。図10に示すように、ステム2 6に第1の半導体レーザ1と第2の半導体レーザ2を距 離る1だけ離して取付け、その出射面側に21a.21 b. 21cの3つの部材からなるビームスプリッタ21 を設ける。これは19と20の2つの反射面があり、分 26 離面19では第2の半導体レーザの光を反射し、第1の 半導体レーザの光を透過させる構造をしている。この分 離面の特性は波長選択性を持たせているが、両者の偏光 方向が異なる場合、偏光ビームスプリッタでもかまわな い。各反射面は光軸に対して4.5 傾斜しており、4.1 に钼当する反射面間の光軸方向距離を持つように部材2 1 bの板厚を設定することにより、第1及び第2の半導 体レーザから出た2つの光ビームを同じ光軸に一致させ るととができる。

【0066】また、第1の半導体レーザ1や第2の半導 【0061】以上説明したように、本実施の形態の光ピ 30 体レーザ2については、ステム上でそれぞれ第1の光輔 22および第2の光輪23上であれば、どの位置に配置 してもビームスプリッタ21で合成した後は同一の光輪 になるため、一方のレーザをコリメータレンズの焦点位 置からずらして、発散光または収束光として用いること も可能である。

> 【0067】とれにより、異なる波長の光ビームを用い て記録再生する複数の異なる規格の光ディスクに対応で き、組立て調整が容易で、しかも小型集積化に適した互 換光ビックアップを実現することができる。

【0068】 <実施の形態3 > 図11は、実施の形態3 の光ビックアップ装置の主要部を示す模式図である。光 ピックアップの構成は、基本的には実施の形態 1(図 1) と同様であるが、半導体レーザチップの取付け方法 及び2つの半導体レーザビームの合成プリズムの構成が 異なる。なお、図11では図1と同一構成要素には同一 符号を付している。

【0069】実施の形態1、2においては、2つのホロ グラム素子11、12はほぼ同一光軸上に配置されてい たため、光利用効率向上や迷光除去のために、3ビーム 50 用回折格子3とホログラム素子11は第2の半導体レー

特闘2000-76689

13

ザ2の光のみを回折するような構深さに設定し、ホログ ラム素子12は第1の半導体レーザ1の光のみを回折す るような襟深さに設定する必要があった。この場合、襟 深さが通常よりも深くなったり、加工公差も厳しくなる という問題点がある。

【0070】本実施の形態は、上記問題点を解決するも の、つまり、波長選択性のホログラムを用いなくても2 つの異なるレーザからの光ビームを共通の受光素子で検 出し、かつ光軸を一致させることができる光ピックアッ ブ装置に関するものであり、図11に示すように、ステ 10 ンを説明した図である。 ム26に第1の半導体レーザ1と第2の半導体レーザ2 を能して取付け、その間に受光素子 1.4 を配置させる標 成とする。

【0071】との実施の形態においては、透明基板1 6.17を各レーザチップの上に別々に配置しており、 このため、各ホログラム素干11、12は一方の光ビー ムのみが通過するように構成できる。そして、各ホログ ラム素子を透過した()次透過光は反射ミラー面25 aを 有するプリズム25および分離面24aを有するビーム スプリッタ24により同一光輪上に合成される。ディス 20 の光学系を示す概略機成図である。 クから反射して戻ってきた光ビームは、それぞれ個別に 独立して位置及び回転調整されたホログラム素子11、 12で共通の受光素子14に導かれる。

【りり72】本構成により作製が難しい波長選択性のホ ログラム素子を用いることなく、異なる波長の光ビーム を用いて記録再生する複数の異なる規格の光ディスクに 対応でき、組立て調整が容易で、しかも小型集積化に適 した互換光ピックアップを実現することが可能となる。 [0073]

【発明の効果】本発明によれば、照射光ビームの波長が 30 6 対物レンズ 異なる光ディスクの互換記録または再生が可能な光ピッ クアップ装置において、各波長の光ビームに対して独立 にホログラム索子の調整を行うことが可能であるため、 各光源の光に対して最適な組立て調整を容易に実現でき る。それにより、レーザ、受光素子の取付け公差やパッ ケージの加工公差などに余裕ができるため、コストを下 けることができる。また、全く同じ受光素子形状で、3 ビーム法と位相差法またはブッシュブル法という異なる トラッキング誤差信号を検出することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1の光ビックアップ装置の

光学系を示す概略模成図である。

【図2】図1の光ピックアップ装置において、第1また は第2の半導体レーザを用いた場合の再生光学系であ

14

【図3】ホログラムの漢深さと回折効率(0次および± 1次)の関係を表した計算結果である。

【図4】ホログラムの漢葉さと回折効率(0次と±1次 の積)の関係を表した計算結果である。

【図5】第1のホログラム素子と受光素子の分割パター

【図6】第2のホログラム素子と受光素子の分割パター ンを説明した図である。

【図?】第1のホログラム素子の調整について説明した 図である。

【図8】第2のホログラム素子の調整について説明した 図である。

【図9】2つのホログラム素子基板の形状を説明した図 である。

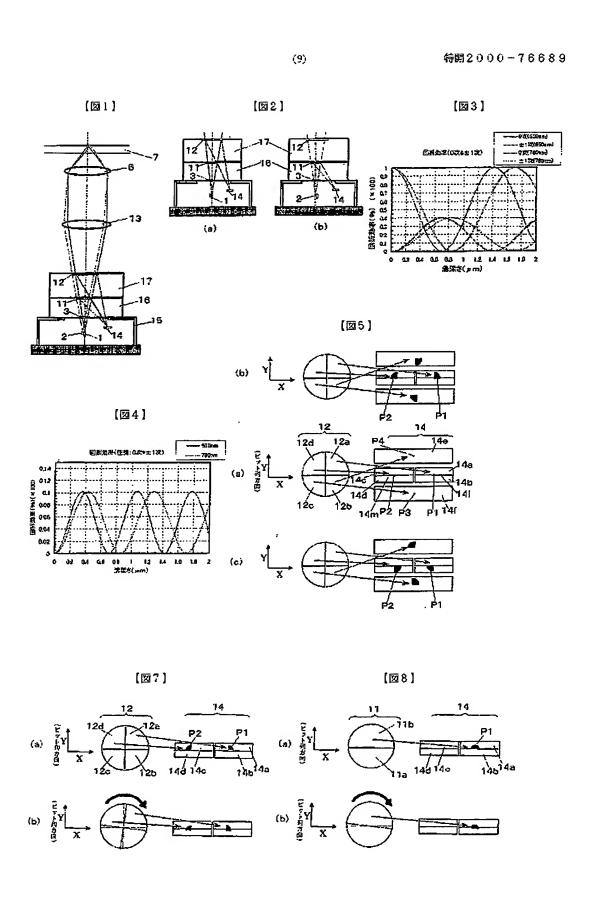
【図10】本発明の実施の形態2の光ビックアップ装置

【図11】本発明の実施の形態3の光ピックアップ装置 の光学系を示す概略構成図である。

【図12】従来の光ピックアップ装置の光学系を示す鉄 略構成図である。

### 【符号の説明】

- 1 第1の半導体レーザ
- 2 第2の半導体レーザ
- 3 3ビーム用回折格子
- 5 格子レンズ
- 7 ディスク
- 8 ホログラム素子
- 9 受光素子
- 11 第2のホログラム素子
- 12 第1のホログラム素子
- 13 コリメータレンズ
  - 14 受光素子
  - 15 レーザバッケージ
  - 16 透明基板
- 40 17 透明基板
  - 18 スペーサ



(10) 待闘2000-76689 [図6] [図9] (a) (b) (c) [図10] (d) [図11] [図12] 19 20

### This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.